

2SB710, 2SB710A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

一般増幅用 / General Amplifier

2SD602, 2SD602A とコンプリメンタリ / Complementary Pair
with 2SD602, 2SD602A

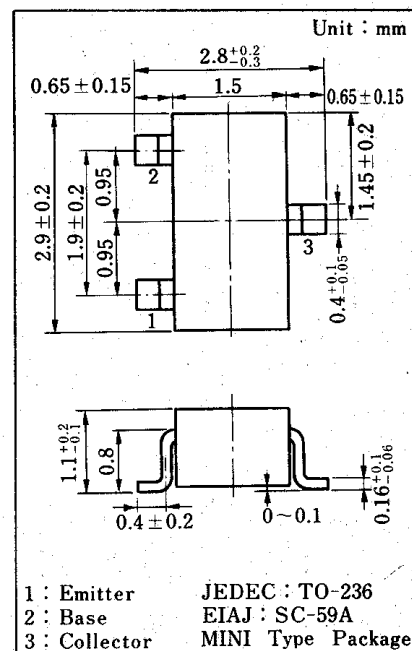
■ 特徴 / Features

- コレクタ電流 I_C が大きい。 / Large I_C
- ミニ型パッケージのため機器の小形化およびテーピング、マガジン包装による自動挿入が可能。

MINI Type package suitable for small equipment, tape and magazine types for automatic insertion are available.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SB710	V_{CBO}	V
	2SB710A	-30	
コレクタ・エミッタ電圧	2SB710	V_{CEO}	V
	2SB710A	-25	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-1	A
コレクタ電流	I_C	-500	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -20\text{ V}, I_E = 0$			-0.1	μA
コレクタ・ベース電圧	2SB710	V_{CBO}	$I_C = -10\text{ }\mu\text{A}, I_E = 0$	-30		V
	2SB710A			-60		
コレクタ・エミッタ電圧	2SB710	V_{CEO}	$I_C = -10\text{ mA}, I_B = 0$	-25		V
	2SB710A			-50		
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = -10\text{ }\mu\text{A}, I_C = 0$	-5			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^{*1}	$V_{CE} = -10\text{ V}, I_C = -150\text{ mA}^{*2}$	85		340	
	h_{FE2}	$V_{CE} = -10\text{ V}, I_C = -500\text{ mA}^{*2}$	40			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -300\text{ mA}, I_B = -30\text{ mA}^{*2}$		-0.35	-0.6	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -300\text{ mA}, I_B = -30\text{ mA}^{*2}$		-1.1	-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = 50\text{ mA}$		200		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$		6	15	pF

^{*2} パルス測定 / Pulse Test

^{*1} h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	Q	R	S
h_{FE1}	85 ~ 170	120 ~ 240	170 ~ 340
Marking Symbol	2SB710 CQ	CR	CS
	2SB710A DQ	DR	DS

■ 形名表示記号(例) / Marking Symbol

